

SHENZHEN YANGJING MICRO-ELECTRONICS CO.,LTD.

TO-220F Plastic-Encapsulate MOSFETS

描述

YJ7N60C为N沟道增强型高压功率MOS 场效应管。该产品可广泛适用于AC-DC开关电源,DC-DC电源转换器,高压H桥PMW马达驱动。

G S

特点

- ★ 7A,600V,RDS(on)(典型值) 0.8Ω
- ★ 低电荷、低反向传输电容
- ★ 开关速度快

极限值(Tc=25℃)

参数名称		符号	数值	单位
漏极—源极电压		VDSS	600	V
漏极电流	TC=25°C	ID	7	A
栅源电压		VGS	±30	V
耗散功率	TC=25°C	PD	48	W
结温		TJ	150	${\mathbb C}$
储存温度		Tstg	-55~150	${\mathbb C}$

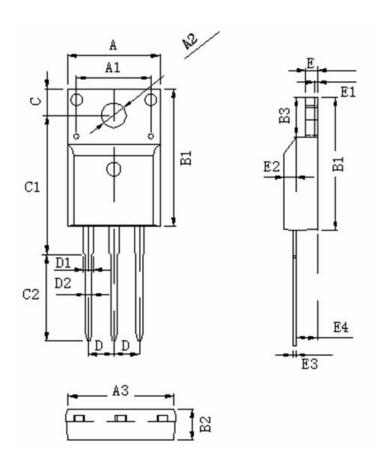
特性参数值 (Tc=25℃)

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单 位
漏源反向电压	BVDSS	VGS=0V, ID=250μA	600			V
漏源截止电流	IDSS	VDS =600V, VGS= 0V			1	μΑ
栅源截止电流	IGSS	$VGS = \pm 30V. VDS = 0V$			±100	nA
通态电阻	RDS(on)	VGS=10V, ID=3.5A		0.8	1.2	Ω
栅-源极开启电压	VGS(th)	$VDS = VGS$, $ID = 250\mu A$	2.0		4.0	V
源漏二极管正向						
导通电压 VFSD		IS=7A,VGS=0V			1.4	V

YJ7N60C

封装外形

- ★ TO-220F
- ★ 图形尺寸



标注	亳米
A	10.03 \pm 0.20
A1	7.00 ± 0.10
A2	3.12 ± 0.10
A3	9.60 ± 0.20
B1	15.75 \pm 0.20
B2	4.72 ± 0.20
В3	6.60 ± 0.20
C	3.20 ± 0.10
C1	15.80 \pm 0.20
C2	9.90 ± 0.2
D	典型值 2.54
D1	1.47(最大)
D2	0.80 ± 0.10
E	2.55 ± 0.20
E1	0.70 ± 0.05
E2	1.00×45°
E3	0.50 ± 0.10
E4	2.80 ± 0.20